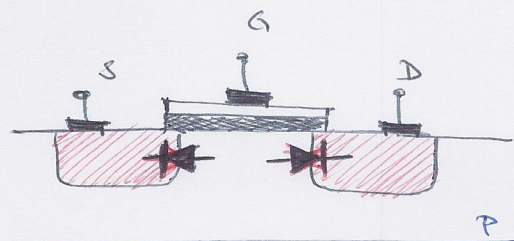


→ Dando nomes aos bois...

→ A favor do entendimento do funcionamento físico do transistor, foram feitas certas simplificações "otimizadas" da física dos transistores MOS. No entanto, devemos agora entender certos aspectos:

(1). Observe que no transistor nMOS ao lado existem duas junções PN em (anti-)série. Nesse caso, se

$V_{GS} = 0$, não importa a tensão V_{DS} aplicada, ~~pois não~~ ^{já que} haverá passagem de corrente ~~pois~~ uma das junções estará reversamente polarizada: **O transistor está em corte!**



(2). O fenômeno de formação do canal (fig 02)

não é imediato. Inicialmente, a tensão positiva na porta repele as lacunas do material tipo-p, deixando íons negativos (que não participam da condução). Ao continuar aumentando V_{GS} , o campo elétrico começa a atrair elétrons (das regiões de tipo-n) e torna possível o acúmulo destes abaixo do isolante.

